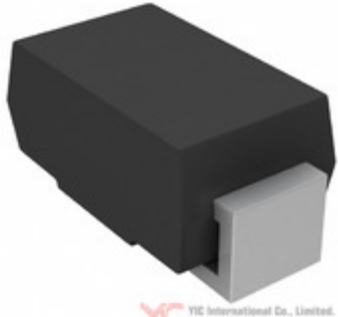
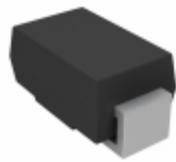

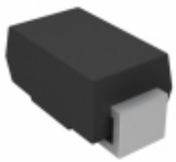

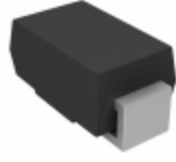


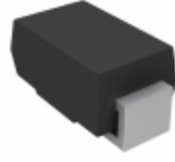
	<h2>US1GHE3_A/H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: US1GHE3_A/H</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1GHE3_A/H.pdf 2.US1GHE3_A/H.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	US1GHE3_A/H
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	4000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	Automotive, AEC-Q101
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	US1G
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	US1GHE3_A/HGICT

US1GHE3_A/H ist neu im Original, Suche US1GHE3_A/H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1GHE3_A/H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>US1GHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GL PHY US1GL PHY</p>	 <p>US1GHE3/5AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>
 <p>US1GHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/61 VISHAY US1GHE3/61 VISHAY</p>	 <p>US1GHE3/61 TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ US1B-M3/61T	↔ US1B-M3/61T	⇒ US1BHE3/5AT	D US1BHE3/5AT	⇒ US1BHE3/61T
⊣ US1BHE3/61T	⊗ US1C-E3/61T	D US1D-13-F	⇒ US1D-E3/61T	⇒ US1D-E3/61T
⊗ US1D-M3/61T	⊣ US1D-M3/61T	⊗ US1DWF-7	↔ US1DWF-7	⇒ US1G-13-F
D US1G-E3/61T	⊗ US1G-E3/61T	⊣ US1G-M3/61T	⊗ US1G-M3/61T	⇒ US1G/11T
⇒ US1GHE3/5AT	↔ US1GHE3/5AT	⊗ US1GHE3/61	⊣ US1GHE3/61T	⇒ US1GHE3/61T
↔ US1GHE3_A/H	⇒ US1GWF-7	D US1GWF-7	⊗ US1J-13-F	⊣ US1J-5AT
⊗ US1J-E3/5AT	D US1J-E3/5AT	⇒ US1J-E3/61T	↔ US1J-E3/61T	⇒ US1J-M3/61T
⊣ US1J-M3/61T	⊗ US1J/11T	↔ US1J/61T	⇒ US1JE-TP	⇒ US1K-13-F
⊗ US1K-E3/61T	⊣ US1K-E3/61T	⊗ US1K-E3D/H	D US1K-M3/5AT	⇒ US1K-M3/5AT
↔ US1K-M3/61T	⊗ US1K-M3/61T	⊣ US1K/11T	⊗ US1KSAFS-13	⇒ US1KSAFS-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited